

Sít TN, jmenovité napětí AC 230 / 400 V.

K ověření selektivity byly použity údaje výrobce

K výpočtu byly použity následující normy : ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, PNE 33 0000-1 ed. 6, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

K zobrazení vypínacích charakteristik byly použity údaje výrobce

Charakteristiky jsou vedeny v 75% proudového rozptylového pásma

Pro výpočty zkratů byla použita ČSN EN 60909-0

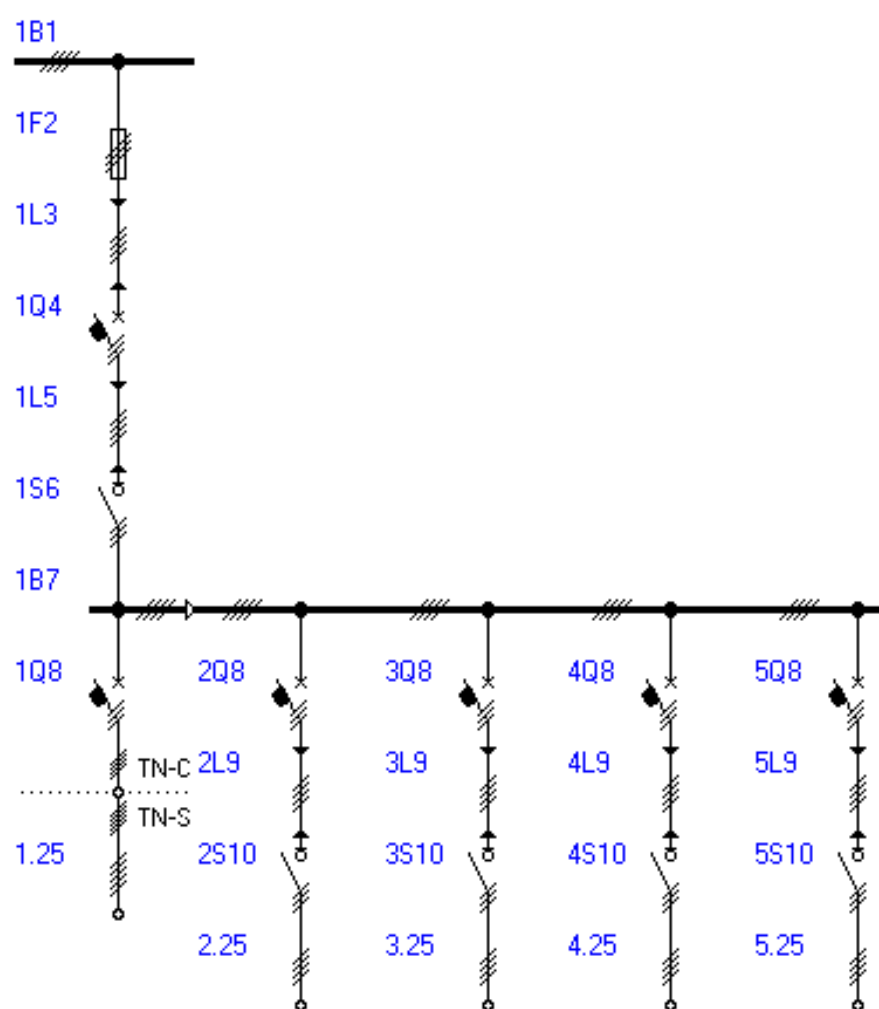
Soupiska strojů, přístrojů a vodičů

Veškeré přístroje jsou uvedeny pouze v základním provedení

Doplňkové příslušenství naleznete v katalogu nebo Konfiguratoru OEZ

Přístroje označené * nemají úplné typové označení a je nutné je vyhledat v katalogu nebo Konfiguratoru OEZ

1F2	* S3PB00...	1 ks
1F2	PNA000 50A gG	3 ks
1L3	CYKY4x25	2 m
1Q4	LTN-40B-3	1 ks
1L5	CYKY4x16	25 m
1S6	MSD-63-3	1 ks
1Q8	LTN-32B-3	1 ks
2Q8	LTN-20B-3	1 ks
2L9	CYKY4x10	40 m
2S10	MSD-32-3	1 ks
3Q8	LTN-20B-3	1 ks
3L9	CYKY4x10	45 m
3S10	MSD-32-3	1 ks
4Q8	LTN-20B-3	1 ks
4L9	CYKY4x10	55 m
4S10	MSD-32-3	1 ks
5Q8	LTN-20B-3	1 ks
5L9	CYKY4x10	55 m
5S10	MSD-32-3	1 ks



1B1	Sít TN U ₂ = 242/420 V I _n = 160 A dU = 0.0 %	I _{k''} = 4.34 kA i _p = 6.37 kA	
1F2	PNA000 50A qG I _n = 50 A	I _l = 120 kA i _o = 3.16 kA	Připojeno pomocí SPB00 Z _s (0,4s) = 693 mΩ, I _a = 333 A, R(50V/5s) = 253 mΩ
1L3	CYKY4x25 I _z = 83 A dU = 0.0 %	t _m = 37 ° C I _{2t} < k2S2 I _{k''} = 4.24 kA i _o = 3.14 kA	2 m v zemi (D) O.K. Z _{sv} < Z _s (0,4s) (215 mΩ < 693 mΩ) Teplota okolí [st. C] : 20 Měrný tepelný odpor [K.m/W] : 2.5 = suchá půda, velmi řídké deště Uspořádání seskupených obvodů : 1 x přímo v zemi
1Q4	LTN-40B I _n = 40 A	I _{cn} = 50 kA* i _o = 3.14 kA	I _i = 180 A Z _s (0,4s) = 1.15 Ω, I _a = 201 A, R(50V/5s) = 249 mΩ 1F2-1Q4 selektivní minimálně do 139 A
1L5	CYKY4x16 I _z = 73 A dU = 0.0 %	t _m = 44 ° C I _{2t} < k2S2 I _{k''} = 2.90 kA i _o = 2.88 kA	25 m v zemi (D) O.K. Z _{sv} < Z _s (0,4s) (277 mΩ < 1.15 Ω) Teplota okolí [st. C] : 20 Měrný tepelný odpor [K.m/W] : 2.0 = suchá půda, řídké deště Uspořádání seskupených obvodů : 1 x přímo v zemi
1S6	MSO-63 I _n = 63 A		
1B7	Sběrnice B = 1 U = 420 V (Un + 5.0%)	i _o = 2.88 kA	I _{k''} = 2.90 kA, i _p = 4.19 kA O.K. Z _{sv} < Z _s (0,4s) (277 mΩ < 1.15 Ω)
1Q8	LTN-32B I _n = 32 A	I _{cn} = 50 kA* i _o = 2.88 kA	I _i = 144 A Z _s (0,4s) = 1.43 Ω, I _a = 161 A, R(50V/5s) = 310 mΩ 1Q4-1Q8 selektivní minimálně do 84 A
1.25	Vývod S = 0 VA U = 420 V (Un + 5.0%)	i _o = 2.88 kA	I _{k''} = 2.90 kA, i _p = 4.19 kA O.K. Z _{sv} < Z _s (0,4s) (280 mΩ < 1.43 Ω)
2Q8	LTN-20B I _n = 20 A	I _{cn} = 50 kA* i _o = 2.88 kA	I _i = 90 A Z _s (0,4s) = 2.31 Ω, I _a = 100 A, R(50V/5s) = 499 mΩ 1Q4-2Q8 selektivní minimálně do 153 A
2L9	CYKY4x10 I _z = 39 A dU = 0.0 %	t _m = 46 ° C I _{2t} < k2S2 I _{k''} = 1.56 kA i _p = 2.24 kA	40 m v izolační stěně (A) O.K. Z _{sv} < Z _s (0,4s) (442 mΩ < 2.31 Ω) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : V izolační stěně Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : Seskupené ve svazku, zapuštěné nebo uzavřené
2S10	MSO-32 I _n = 32 A		
2.25	Vývod S = 0 VA U = 420 V (Un + 5.0%)	I _{k''} = 1.56 kA i _p = 2.24 kA	O.K. Z _{sv} < Z _s (0,4s) (442 mΩ < 2.31 Ω)

3Q8	LTN-20B In = 20 A		Icn = 50 kA* io = 2.88 kA	Ii = 90 A Zs(0,4s) = 2.31 Ohm, Ia = 100 A, R(50V/5s) = 499 mOhm 1Q4-3Q8 selektivní minimálně do 153 A
3L9	CYKY4x10 Iz = 39 A dU = 0.0 %	tm = 46 ° C I2t < k2S2	Ik'' = 1.47 kA ip = 2.12 kA	45 m v izolační stěně (A) O.K. Zsv < Zs(0,4s) (462 mOhm < 2.31 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : V izolační stěně Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : Seskupené ve svazku, zapuštěné nebo uzavřené
3S10	MSO-32 In = 32 A			
3.25	Vývod S = 0 VA U = 420 V (Un + 5.0%)		Ik'' = 1.47 kA ip = 2.12 kA	O.K. Zsv < Zs(0,4s) (462 mOhm < 2.31 Ohm)
4Q8	LTN-20B In = 20 A		Icn = 50 kA* io = 2.88 kA	Ii = 90 A Zs(0,4s) = 2.31 Ohm, Ia = 100 A, R(50V/5s) = 499 mOhm 1Q4-4Q8 selektivní minimálně do 153 A
4L9	CYKY4x10 Iz = 39 A dU = 0.0 %	tm = 46 ° C I2t < k2S2	Ik'' = 1.32 kA ip = 1.90 kA	55 m v izolační stěně (A) O.K. Zsv < Zs(0,4s) (502 mOhm < 2.31 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : V izolační stěně Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : Seskupené ve svazku, zapuštěné nebo uzavřené
4S10	MSO-32 In = 32 A			
4.25	Vývod S = 0 VA U = 420 V (Un + 5.0%)		Ik'' = 1.32 kA ip = 1.90 kA	O.K. Zsv < Zs(0,4s) (502 mOhm < 2.31 Ohm)
5Q8	LTN-20B In = 20 A		Icn = 50 kA* io = 2.88 kA	Ii = 90 A Zs(0,4s) = 2.31 Ohm, Ia = 100 A, R(50V/5s) = 499 mOhm 1Q4-5Q8 selektivní minimálně do 153 A
5L9	CYKY4x10 Iz = 39 A dU = 0.0 %	tm = 46 ° C I2t < k2S2	Ik'' = 1.32 kA ip = 1.90 kA	55 m v izolační stěně (A) O.K. Zsv < Zs(0,4s) (502 mOhm < 2.31 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : V izolační stěně Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : Seskupené ve svazku, zapuštěné nebo uzavřené
5S10	MSO-32 In = 32 A			
5.25	Vývod S = 0 VA U = 420 V (Un + 5.0%)		Ik'' = 1.32 kA ip = 1.90 kA	O.K. Zsv < Zs(0,4s) (502 mOhm < 2.31 Ohm)